Влияние спинового и валентного состояний ионов Со на кинетические свойства соединений Ho_{1-x}Sr_xCoO_{3-δ} и Er_{1-x}Sr_xCoO_{3-δ}

© А.А. Козловский, В.Ф. Хирный, А.В. Семенов, В.М. Пузиков

HTK "Институт монокристаллов" НАН Украины, Харьков, Украина E-mail: khirnyi@isc.kharkov.ua

(Поступила в Редакцию в окончательном виде 5 августа 2010 г.)

В области температур T > 77 К исследованы проводимость и эффект Зеебека в керамиках на основе кобальтитов с перовскитоподобной структурой Ho_{1-x}Sr_xCoO_{3- $\delta}$} (x = 0.65, 0.75, 0.85, 0.95) и Er_{1-x}Sr_xCoO_{3- δ} (x = 0.75, 0.85, 0.95). Все изученные соединения характеризуются прыжковой проводимостью с переменной длиной прыжка с температурной зависимостью электросопротивления, соответствующей закону Мотта. В соединении Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3- δ} при повышении температуры до 250 К обнаружен вклад в проводимость от термически возбужденных ионов Co³⁺. Коэффициент Зеебека исследованных систем понижается при увеличении содержания стронция и температуры. Показано, что для объяснения такого поведения необходимо учитывать расщепление 3*d*-уровней и зарядовую диспропорционализацию ионов кобальта.

1. Введение

05

Кобальтиты редкоземельных металлов, обладающие структурой перовскита ABO_3 , характеризуются очень богатым набором физических свойств, интересных как с точки зрения понимания природы явлений в сильнокоррелированных электронных системах, так и для практического использования. Несмотря на большое количество публикациий, многие вопросы физики этих соединений остаются открытыми. Так, проблема спиновых переходов в LoCoO₃ и в настоящее время, полвека спустя после начала изучения, продолжает вызывать дискуссии [1,2].

Физические свойства перовскитоподобных редкоземельных кобальтитов с гетеровалентными замещениями в узле А определяют следующие факторы: валентность и концентрация замещающего элемента, эффективный ионный радиус ионов, занимающих узел А, и дисперсия распределения А-ионов [3,4]. В основном исследовались редкоземельные кобальтиты, легированные щелочноземельными элементами. В настоящее время кинетические и магнитные свойства наиболее полно изучены в системе $La_{1-x}Sr_xCoO_3$, высокоспиновое состояние ионов Со³⁺ в которой стабилизировано за счет снижения химического давления при введении стронция [5]. Внимание исследователей к этой системе было вызвано целым комплексом ее уникальных свойств: электронной и магнитной фазовой сепарацией, значительным магнеторезистивным эффектом, изменением типа проводимости и природы носителей заряда при варьировании концентрации стронция и температуры, большой величиной термоэдс (по данным [6] величина коэффициента Зеебека в La_{0.95}Sr_{0.05}CoO₃ при комнатной температуре составляет 710 µV/K). Кобальтиты других редкоземельных элементов $Ln_{1-x}A_xCoO_3$ изучались гораздо меньше.

Особый интерес представляет исследование системы с ионными радиусами r_{Ln} лантаноидов, намного меньшими, чем у лантана: Ln = Ho, Er. Возрастание химического давления при уменьшении r_{In} будет приводить к увеличению энергетического расщепления 3d-уровней ионов кобальта в кристаллическом поле (спиновой щели Δ) и, следовательно, к изменению состояния носителей заряда. Кроме того, в таких кобальтитах при их легировании щелочно-земельными элементами более выражены эффекты, обусловленные несоответствием размеров редкоземельных и щелочно-земельных ионов. Возрастание энергетической щели между t2g- и eg-состояниями и беспорядка в распределении А-катионов доложно приводить к радикальному изменению кинетических свойств таких систем по сравнению со свойствами легированных лантановых кобальтитов. Интерес вызывает также возможность возникновения спиновых переходов, обусловленная увеличением спиновой щели в легированных редкоземельных кобальтитах с $r_{Ln} < r_{La}$. Появление спиновых переходов в системе с переменной валентностью Со³⁺/Со⁴⁺ также будет сказываться на ее кинетических свойствах: проводимости, магнеторезистивности, термоэдс. До настоящего времени эти явления в гольмиевых и эрбиевых кобальтитах, легированных щелочно-земельными элементами, не изучались. Целью настоящей работы было изучение электрической проводимости и эффекта Зеебека в гольмиевых и эрбиевых кобальтитах, легированных стронцием.

2. Образцы и методика эксперимента

Керамические образцы $Ho_{1-x}Sr_xCoO_{3-\delta}$ (x = 0.65, 0.75, 0.85 и 0.95) и $Er_{1-x}Sr_xCoO_{3-\delta}$ (x = 0.75, 0.85 и 0.95) синтезировали по стандартной твердофазной технологии, включающей прессование и спекание по-



Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы образцов $Ho_{0.25}Sr_{0.75}CoO_{3-\delta}(a)$ и $Er_{0.15}Sr_{0.85}CoO_{3-\delta}(b)$.

рошков SrCO₃, CoO, Er₂O₃ и Ho₂O₃ [7]. Образцы имели форму прямоугольных параллелепипедов размером $0.25 \times 0.25 \times 2.5$ сm. Рентгенофазовыми исследованиями была установлена однофазность образцов. Типичные дифрактограммы приведены на рис. 1. Синтезированные соединения характеризовались перовскитоподобной кристаллической структурой с орторомбически искаженной элементарной ячейкой (пространственная группа *Pbnm*). Кислорододефицитный индекс, определенный при химическом анализе образцов, сотавлял $\delta = 0.4 \pm 0.06$.

Измерения термоэдс проводили интегральным методом относительно меди. В качестве припоя, обеспечивающего контакт между керамикой и медью, использовали сверхчистый индий, наносимый при помощи ультразвуковой пайки. Электрическое сопротивление определяли четырехзондовым способом на постоянном токе в режиме стабилизации температуры с суммарной погрешностью менее 10%.

3. Результаты и обсуждение

Измерения электрического сопротивления проводили в температурном интервале от 77 до 300 К (для образцов $Ho_{0.15}Sr_{0.85}CoO_{3-\delta}$ и $Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3-\delta}$ до T = 440 К). Температурные зависимости удель-

ного электрического сопротивления $\rho(T)$ систем $Ho_{1-x}Sr_xCoO_{3-\delta}$ и $Er_{1-x}Sr_xCoO_{3-\delta}$ качественно соответствовали полупроводниковому типу $d\rho/dT < 0$ во всем исследованном интервале изменения T (рис. 2). Полупроводниковый характер проводимости с зависимостью $\rho(T)$, близкой к экспоненциальной, можно описать в рамках нескольких физических моделей. Стандартное термоактивационное соотношение для полупроводниковых систем (закон Аррениуса) имеет вид

$$\rho(T) = \rho_{\infty} \exp(E_a/k_B T), \qquad (1)$$

где ρ_{∞} — константа, соответствующая удельному электросопротивлению при $T \to \infty$, k_B — постоянная Больцмана. Величина E_a имеет смысл ширины запрещенной зоны в случае зонной проводимости собственного полупроводника либо энергии активации прыжковой проводимости между ближайшими соседями в случае легированного полупроводника [8].

В рамках модели прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка (VRH) температурная зависимость электросопротивления имеет вид

$$\rho(T) = \rho_{\infty} \exp(T_0/T)^{1/n}, \qquad (2)$$

где *T*₀ — характеристическая температура (энергия локализации носителей заряда в единицах температуры).



Рис. 2. Температурная зависимость удельного электросопротивления керамик $Ho_{1-x}Sr_xCoO_{3-\delta}(a)$ и $Er_{1-x}Sr_xCoO_{3-\delta}(b)$.

Показатели степени 1/n = 1/4 и 1/n = 1/3 соответствуют трехмерной (3D) и двумерной (2D) прыжковой проводимости Мотта [8]. Соотношение (2) с показателем 1/n = 1/2 рассматривается в модели Эфроса-Шкловского [9]. В адиабатическом приближении модели прыжков малых поляронов [10] активационная энергия для проводимости представляет собой сумму

$$E_a = E_g/2 + W_H, \tag{3}$$

где E_g — энергия возбуждения носителей заряда, W_H — энергия, необходимая для осуществления прыжков. Зависимость сопротивления от температуры в этом случае может быть выражена как

$$\rho(T) = \rho_0 T \exp(E_a/k_B T). \tag{4}$$

Величина ρ_0 определяется следующей формулой:

$$\rho_0 = k_B / N e^2 \omega_p l^2, \tag{5}$$

где e — элементарный заряд, N — концентрация поляронов, ω_p — частота оптических фононов, l — длина прыжков поляронов.

Для идентификации типа проводимости была выполнена обработка экспериментальных результатов в координатах $\ln \rho$ в зависимости от $1/T^{1/n}$ (n = 1, 2,3, 4) и $\ln(\rho/T)$ от 1/T. Спрямление экспериментальных зависимостей в соответствующих координатах должно означать применимость данной модели для описания проводимости образца. Проведенный анализ показал, что для всех образцов системы $Er_{1-x}Sr_xCoO_{3-\delta}$ температурная зависимость электросопротивления описывалась законом Мотта для 3D-проводимости (рис. 3, *a*). В соединениях системы $Ho_{1-x}Sr_xCoO_{3-\delta}$ проводимость также осуществлялась по прыжковому механизму с переменной длиной прыжка моттовского типа. В образце с x = 0.95 выполнялся закон Мотта для трехмерного случая (рис. 3, b), при x = 0.75 и 0.85 наблюдалась 2D-проводимость Мотта (рис. 3, c). Для соединения Но_{0.35}Sr_{0.65}CoO₃₋₆ ни один из рассмотренных механизмов не подходил для описания экспериментальных зависимостей $\rho(T)$ во всей исследованной области температур. Линейные участки появлялись лишь в низкотемпературной части кривых $\ln \rho (1/T^{1/4})$. При достижении температуры T^* , отмеченной на рис. 3, *b* вертикальной стрелкой, линейность нарушалась.

Исходя из экспериментальных данных был выполнен расчет параметров, характеризующих прыжковую проводимость. Характеристическая температура Мотта T_0 для прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка определялась как

$$T_0 = d(\ln \rho) / d(T^{1/n}).$$
(6)

Плотность локализованных состояний вблизи уровня Ферми $N(E_{\rm F})$ рассчитывали из соотношений Мотта

2 a x = 0.750.85 0.95 .2 dul -6 -100.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.24 $T^{-1/4}$. K^{-1/4} h x = 0.650.95 -2 ηp -100.26 0.28 0.30 0.22 0.24 0.32 0.34 $T^{-1/4}, \, \mathrm{K}^{-1/4}$ 0 0 x = 0.750.85 dul -8 -100.18 0.20 0.22 0.24 0.14 0.66 $T^{-1/3}$, $K^{-1/3}$

Рис. 3. Обработка экспериментальных зависимостей $\rho(T)$ в координатах, соответствующих VRH-проводимости. *a*, *b* — 3D-проводимость Мотта, *c* — 2D-проводимость Мотта. Точки соответствуют экспериментальным данным, линии — их линейной аппроксимации. Кривые на части *a* соответствуют образцам системы $\text{Er}_{1-x}\text{Sr}_x\text{CoO}_{3-\delta}$, на частях *b*, *c* — образцам системы $\text{Ho}_{1-x}\text{Sr}_x\text{CoO}_{3-\delta}$ с разным содержанием стронция *x*.

Таблица 1. Средний радиус ионов в узле A, характеристическая температура T_0 , плотность локализованных состояний вблизи уровня Ферми $N(E_{\rm F})$ соединений с двумерной проводимостью Мотта

Состав	$\langle r_A angle$, Å	$T_0, 10^5 \mathrm{K}$	$N(E_{\rm F})$, 10 ¹³ eV ⁻¹ · cm ⁻²
$\begin{array}{l}Ho_{0.25}Sr_{0.75}CoO_{3-\delta}\\Ho_{0.15}Sr_{0.85}CoO_{3-\delta}\end{array}$	1.11025	9.62	1.47
	1.13815	5.37	2.62

Таблица 2. Средний радиус ионов в узле A, характеристическая температура T_0 , плотность локализованных состояний вблизи уровня Ферми $N(E_{\rm F})$, средняя длина R_h и энергия прыжков E_h для соединений с трехмерной проводимостью Мотта

x	$\langle r_A angle, { m \AA}$	$T_0, 10^5 \mathrm{K}$	$N(E_{\rm F}),$ 10 ¹⁹ eV ⁻¹ ·cm ⁻³	$\begin{array}{c} R_h, \text{ Å} \\ (T = 220 \text{ K}) \end{array}$	$E_h, \text{ meV} \\ (T = 220 \text{ K})$	
$\operatorname{Ho}_{1-x}\operatorname{Sr}_x\operatorname{CoO}_{3-\delta}$						
0.65	1.08235	520	3.2	41.6	102.4	
0.95	1.16605	5.9	281.7	13.6	33.6	
$\mathrm{Er}_{1-x}\mathrm{Sr}_x\mathrm{CoO}_{3-\delta}$						
0.75	1.1075	574	2.9	42.4	106.9	
0.85	1.1365	398.5	4.2	38.7	97.5	
0.95	1.1655	6.2	266.6	13.7	34.5	

для характеристической температуры в случае 3D-проводимости [8]

$$T_0 = B_0^4 \left(\alpha^3 / k_B N(E_{\rm F}) \right) \tag{7}$$

и 2D-проводимости

$$T_0 = 3\alpha^2 / k_B N(E_{\rm F}), \tag{8}$$

где $\alpha = 1/a$ — величина, обратная длине затухания волновой функции локализованного состояния вблизи уровня Ферми (длине локализации), B_0 — константа, значение которой лежит в интервале 1.7–2.5. В кобальтитах $B_0^4 = 18.108$, a = 5 Å [11].

Средняя длина R_h и энергия прыжков E_h были вычислены с использованием соотношений из [12], которые являются следствиями формул Мотта для 3D-проводимости,

$$R_h = (3/8)a(T_0/T)^{1/4},$$
(9)

$$E_h = (1/4)k_B T^{3/4} T_0^{1/4}.$$
 (10)

На состояние носителей заряда в перовскитоподобных соединениях влияет величина химического давления, которая зависит от среднего (эффективного) радиуса катионов, занимающих узел *A*,

$$\langle r_A \rangle = \sum y_i r_i, \tag{11}$$

где y_i — концентрация *А*-катионов сорта i ($\sum y_i = 1$), r_i — радиус *А*-катионов сорта i. Для расчета $\langle r_A \rangle$

использовались значения ионных радиусов в системе Шеннона [13].

Величины $\langle r_A \rangle$, а также параметры, характеризующие двумерную и трехмерную VRH-проводимость, приведены в табл. 1 и 2 соответственно. Полученные значения T_0 и $N(E_F)$ являются типичными для подобных систем [11,14]. Средняя длина прыжков носителей заряда R_h составляла несколько межатомных расстояний, что закономерно для случая проводимости с переменной длиной прыжка. Значение средней энергии прыжков по порядку величины совпадало с полученным в [11] для перовскитоподобных соединений $Y_{1-x}Ca_xCoO_{3-\delta}$.

При возрастании величины $\langle r_A \rangle$ значения характеристической температуры понижаются. Данная тенденция характерна как для случая 3D-, так и для случая 2D-проводимости (табл. 1 и 2). При увеличении эффективного радиуса катионов узла A наблюдается также возрастание плотности локализованных состояний вблизи уровня Ферми и понижение средней энергии и длины прыжков носителей заряда. Величины характеристической температуры Мотта и производных от нее параметров, характеризующих 3D-проводимость, для эрбиевых и гольмиевых кобальтитов с одинаковым индексом легирования x = 0.95 различаются мало (табл. 2).

Для объяснения обнаруженных корреляций между величиной $\langle r_A \rangle$ и параметрами прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка необходимо учесть следующие обстоятельства. При увеличении $\langle r_A \rangle$ химическое давление в системе понижается. Это вызывает удлинение связей Со-О и уменьшение *p*-*d*-гибридизации электронных облаков кислорода и кобальта. Влияние создаваемого кислородным окружением кристаллического поля на ионы кобальта уменьшается, а энергетическая щель Δ между t_{2g} - и e_g -состояниями сужается. Зона e_g электронов расширяется, локализация ослабляется, что проявляется в уменьшении характеристической температуры Мотта и возрастании плотности локализованных состояний в узкой полосе вблизи уровня Ферми. Поэтому туннелирование носителей заряда между локализованными состояниями облегчается. Это приводит к возрастанию средней длины и энергии прыжков. Отсутствие качественных различий во влиянии значения $\langle r_A \rangle$ на T_0 и производные от нее величины, характеризующие VRH-проводимость, между эрбиевой и гольмиевой системами объясняется близостью радиусов Ho³⁺ и Er³⁺: $r_{\rm Ho} = 0.901$ Å, $r_{\rm Er} = 0.89$ Å [13].

Нарушение линейного характера зависимостей $\ln \rho (1/T^{1/4})$ в Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3- δ} при повышении температуры до $T > T^*$ свидетельствует о том, что механизм проводимости в этой температурной области имеет сложный характер и не сводится только к прыжкам между локализованными состояниями (рис. 3, *b*). Следует отметить, что обработка зависимостей $\rho(T)$ этого соединения в координатах, соответствующих другим прыжковым механизмам (соотношения (1) и (2)), показала, что ни одна из этих моделей не дает описания проводимости

не только в целом, но и в каких-либо отдельных температурных интервалах, о чем свидетельствовало отсутствие линейных участков на соответствующих графиках.

Отклонение кривой $\ln \rho (1/T^{1/4})$ от линейной зависимости в сторону понижения ρ может быть интерпретировано как появление в образце второго канала проводимости. Этот канал возникает при $T = T^*$ в полупроводниковой матрице, характеризуемой VRH-проводимостью моттовского типа. Поэтому для описания электрической проводимости во всем исследованном температурном интервале использовалась модель, в которой образцы представляли собой два параллельных резистора с проводимостями σ_1 и σ_2 (подобная рассмотренной в работе [15]). Причиной появления второго канала проводимости в Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3-δ} является термическое возбуждение ионов кобальта в высокоспиновое (HS) состояние, приволяшее к возникновению делокализованных носителей. Проводимость образца в рассматриваемой модели представляет собой сумму проводимостей двух параллельных каналов

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2. \tag{12}$$

Первое слагаемое соответствует проводимости полупроводниковой матрицы, осуществляемой по прыжковому механизму: $\sigma_1 = \rho^{-1}$, где ρ представляет собой величину (2) при n = 4. Второе слагаемое описывает вклад в проводимость от возбужденных состояний ионов Co³⁺

$$\sigma_2 = \sigma_{2\infty} n, \tag{13}$$

где $\sigma_{2\infty}$ — проводимость при $T \to \infty$, n — концентрация термически возбуждаемых из низкоспинового (LS) в высокоспиновое состояние e_g -электронов. Величина n совпадает с функцией, описывающей концентрацию ионов кобальта, перешедших в высокоспиновое состояние [5],

$$n = g_3/[g_3 + \exp(\Delta/k_B T)], \qquad (14)$$

где g_3 — мультиплетность возбужденного состояния ионов Co³⁺, Δ — спиновая щель.

Аппроксимация экспериментальных зависимостей $\rho(T)$ по формулам (12)–(14) проводилась при значении $g_3 = 33$. Этой величине мультиплетности соответствует малое энергетическое различие между состоянием с промежуточным спином (IS) и высокоспиновым состоянием ионов кобальта [16]. Результаты выполненной аппроксимации приведены на рис. 4. Сплошная кривая, соответствующая модели двухканальной проводимости, очень близка к экспериментальной зависимости ho(T). Штриховой линией показана зависимость, соответствующая проводимости матрицы в отсутствие спиновых возбуждений и построенная с использованием формулы для 3D-проводимости Мотта. Температура расхождения кривых, соответствующих одноканальной проводимости и двухканальной модели, совпадает с $T^* = 250 \,\mathrm{K}$. Аппроксимация $\rho(T)$ была выполнена при следующих значениях подгоночных параметров: $\rho_{\infty} = 6 \cdot 10^{-13} \,\Omega \cdot m$,



Рис. 4. Экспериментальная зависимость $\rho(T)$ соединения Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3- δ} и ее аппроксимация, соответствующая модели двухканальной проводимости.

 $\sigma_{2\infty} = 3.4 \cdot 10^4 \,(\Omega \cdot m)^{-1}$ и $\Delta = 200$ meV. Величина энергетического расщепления 3*d*-уровней в кристаллическом поле Δ оказались на порядок ниже, чем в нелегированном соединении HoCoO₃ [17,18]. Это различие согласуется с рассмотренным выше механизмом влияния химического давления, связанного с размерами катионов узла *A*, на значение спиновой щели.

Присутствие в образцах возбужденных спиновых состояний не означает появление в них магнитоупорядоченного состояния. По данным измерений магнитной восприимчивости соединение $Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3-\delta}$ с обнаруженным вкладом в проводимость от возбужденных спиновых состояний (как и все остальные исследованные кобальтиты) находится в парамагнитном состоянии. Это свидетельствует о слабости или отсутствии двойного обменного взаимодействия между ионами кобальта в исследованном интервале температур.

Термоэдс в соединениях $\text{Er}_{1-x}\text{Sr}_x\text{CoO}_{3-\delta}$ и $\text{Ho}_{1-x}\text{Sr}_x\text{CoO}_{3-\delta}$ определялась в температурном интервале от T = 300 K (для некоторых образцов от T = 100 K) до $T \cong 600 \text{ K}$. Температурная зависимость коэффициента Зеебека *S* имела убывающий характер (рис. 5). Основными носителями заряда в большинстве соединений были дырки. В образцах с концентрацией стронция x = 0.95 при температурах выше комнатной знак термоэдс соответствовал электронному типу проводимости.

Основная особенность эффекта Зеебека, которая проявляется как в гольмиевых, так и в эрбиевых кобальтитах, легированных стронцием, — это тенденция понижения величины *S* при увеличении содержания стронция *x*. Для объяснения обнаруженных закономерностей изменения термоэдс с концентрацией допирующего элемента и температурой необходимо учесть, что исследуемые соединения представляют собой системы со смешан-



Рис. 5. Температурные зависимости коэффициента Зеебека для систем $Ho_{1-x}Sr_xCoO_{3-\delta}$ (*a*) и $Er_{1-x}Sr_xCoO_{3-\delta}$ (*b*).

ной валентностью. Замена редкоземельных ионов Ho³⁺ и Er³⁺ на щелочно-земельный ион Sr²⁺ переводит ионы кобальта (принцип сохранения электрической нейтральности) в смешанное валентное состояние Co³⁺/Co⁴⁺. При этом содержание ионов Co⁴⁺ совпадает с индексом замещения: $Ln_{1-x}Sr_xCo_{1-x}^{3+}Co_x^{4+}O_3$. На ионах Co⁴⁺ располагаются дырки, которые в кобальтитах вносят основной вклад в зарядовый транспорт, поскольку намного более подвижны, чем электроны [19].

Поэтому различия в величинах *S* соединений с разным индексом легирования могут быть объяснены с привлечением формулы Heikes, которую традиционно используют для описания термоэдс систем со смешанной валентностью M^n/M^{n+1} [20,21],

$$S = -(k_B/e)\ln[\mathrm{Co}^{4+}/\mathrm{Co}^{3+}], \qquad (15)$$

где Co⁴⁺ и Co³⁺ — концентрация трех- и четырехвалентных ионов кобальта соответственно.

Применение формулы (15) не может объяснить появление сильной температурной зависимости удельной термоэдс у образца $Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3-\delta}$, начиная с температур, соответствующих формированию в нем канала проводимости, обусловленного возбужденными спиновыми состояниями (рис. 5, а). Поэтому для объяснения такого поведения необходимо учесть, что трехвалентные ионы кобальта в исследуемых системах при низких температурах находятся в низкоспиновом состоянии Co^{II} (спин s = 0) с конфигурацией электронов $t_{2_{\sigma}}^{6} e_{\sigma}^{0}$. При повышении температуры под влиянием тепловых флуктуаций происходит постепенное уменьшение заселенности LS-состояния Co^{III} и появление трехвалентных ионов кобальта Со³⁺, находящихся в возбужденных спиновых состояниях: HS $(t_{2g}^4 e_g^2; s = 2)$ либо IS $(t_{2g}^5 e_g^1; s = 2)$ s = 1) [18]. При этом электроны из π -зоны, ассоциируемой с локализованными t_{2g}-орбиталями, переходят в делокализованную *σ*-зону, созданную *e*_g-орбиталями. Изменение отношения концентраций Co³⁺/Co^{III} с температурой описывается соотношением (5).

Поэтому при интерпретации результатов измерения термоэдс необходимо использовать модифицированную формулу Heikes для коэффициента Зеебека, которая учитывает спиновые состояния ионов кобальта и число вырожденных конфигураций этих состояний [16],

$$S = -(k_B/e) \ln [(g_3/g_4)(x/(1-x))], \qquad (16)$$

где g_4 — число вырожденных конфигураций спиновых состояний ионов $\mathrm{Co}^{4+}, \ x = \mathrm{Co}^{4+}/\mathrm{Co}$ — число узлов Со, занимаемых ионами Со⁴⁺. Также нужно учесть, что при возрастании температуры в образцах протекает реакция зарядовой диспропорционализации ионов Со³⁺, наблюдаемая в кобальтитах с различным химическим составом и кристаллической структурой: перовскитах LaCoO_{3- δ} [22] и La_{1-x}Sr_xCoO_{3- δ} [23], слоистых соединениях $LnBaCo_2O_{5.50\pm\delta}$ (Ln = Y, Gd, Eu, Sm) [24] и Na_xCoO₂ [25]. (Следует отметить, что реакция диспропорционализации ионов переходных металлов с частично заполненными 3d-электронными подуровнями происходит в большинстве их окислов. Примерами могут служить Mn^{3+} $(t_{2g}^3 e_g^1)$ в Y_{1-v}Ca_vMnO₃ [26] и La_{1-v}Ca_vMnO₃ [26,27], Fe⁴⁺ ($t_{2\sigma}^3 e_{\sigma}^1$) в CaFeO₃ [28] и (*Ln*_{0.6}Sr_{0.4})_{0.99}Fe_{0.8}Co_{0.2}O_{3-δ} [29]; V⁴⁺ (t_{2g}^1) в La₂V₂O₇ [30].) Поскольку пары Co³⁺–Co³⁺ метастабильны, распадаясь на Со²⁺-Со⁴⁺, реакцию диспропорционализации записывают в виде [22]

$$2Co^{3+} = (Co^{2+})^{\cdot} + (Co^{4+})^{\prime}, \qquad (17)$$

где точкой отмечены электроны, находящиеся на ионах Co^{2+} , а штрихом — дырки, расположенные на ионах Co^{4+} .

В этой реакции принимают участие лишь возбужденные ионы кобальта, имеющие электроны на *e*_g-подуровнях, т.е. ионы, находящиеся в HS- или IS-состояниях. Условие теплового равновесия при выполнении реакции диспропорционализации имеет вид [31]

$$(\mathrm{Co}^{2+})(\mathrm{Co}^{4+})/(\mathrm{Co}^{3+})^2 = \exp(-E_D/k_BT),$$
 (18)

где (Co²⁺), (Co⁴⁺) и (Co³⁺) — мольные части соответствующих ионов, E_D — изменение свободной энергии



Рис. 6. Сравнение экспериментальных зависимостей S(T) с расчетными для соединения Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3- δ}.

системы спинов, ассоциируемое с реакцией диспропорционализации, т.е. энергия активации диспропорционализации [32]. Для получения соотношения между концентрацией Co⁴⁺ и изменением температуры необходимо также учесть уравнение баланса масс [31]

$$Co^{III} + Co^{3+} + Co^{2+} + Co^{4+} = 1.$$
 (19)

Математическим решением системы уравнений (5), (17)–(19) является

$$Co^{4+} = \left\{ 1 \pm \left[1 - \exp(-E_D/k_B T) \right]^{0.5} \right\} / \left\{ 4 + (1/g_3) \times \exp(\Delta/k_B T) \right\}.$$
(20)

Выражение (20) со знаком плюс в правой части предполагает увеличение концентрации четырехвалентных ионов кобальта при возрастании энергии диспропорционализации E_D , что не имеет физического смысла. Поэтому рассматриваться будет только решение со знаком минус, подставляя которое в модифицированную формулу Heikes (16), можно получить непосредственную зависимость величины удельной термоэдс от температуры.

Рассчитанная по (16) и (20) зависимость S(T) в области температур резкого падения термоэдс кобальтита $Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3-\delta}$ близка к экспериментальной (рис. 6). Для выполнения аппроксимации S(T) был проведен анализ всех возможных сочетаний величин g_3 и g_4 из [16], соответствующих LS-, HS- и IS-состояниям ионов Co^{3+} и Co^{4+} , а также ситуациям, когда два состояния энергетически мало различимы (LS + HS, LS + IS, HS + IS), и в случае малых различий энергий во всех трех состояниях (LS + IS + HS). Всего было проанализировано 34 сочетания. Технически подгонка осуществлялась при помощи компьютерной программы Origin 7.0. Аппроксимация оказалась единственно возможной при $g_3 = 18 + 15 = 33$ (ситуация HS + IS для

ионов Co³⁺) и $g_4 = 6$, соответствующей HS-состоянию Co⁴⁺ [16]. (Считается [31], что ионы Co⁴⁺, образовавшиеся при диспропорционализации, находятся в HSсостоянии. Исследованиями электронной спектроскопии было установлено, что высокоспиновое состояние для Co⁴⁺ является энергетически более выгодным [33].)

Ширина энергетической щели, отделяющей возбужденные состояния ионов Co^{3+} от низкоспиновых, составляла $\Delta = 200 \text{ meV}$, что полностью совпадает со значением этого параметра, полученным при аппроксимации температурных зависимостей электросопротивления в модели двухканальной проводимости.

Изменение подгоночного параметра E_D с температурой в области температур быстрого снижения термоэдс с очень хорошей точностью описывается функциональной зависимостью вида

$$E_D (\text{meV}) = E_{D_0} + A \exp\{-[T(K) - T_0]^2 / B\}$$
(21)

(рис. 7). Подгоночные константы составляли: $E_{D_0} = 5.9 \text{ meV}, A = 3.3 \text{ meV}, B = 2000 \text{ K}^2, T_0 = 242.5 \text{ K}.$ Полученные значения энергии диспропорционализации характерны для кобальтитов [31].

Необходимо отметить, что температура, при которой характер зависимости S(T) в рассматриваемом образце изменялся (температура начала быстрого понижения величины S), совпадала с температурой появления канала проводимости, связанного с возбуждениями спиноовой подсистемы ионов Co^{3+} : $T^* \cong 250$ К. Это обусловлено общей физической природой рассматриваемых явлений: термическое возбуждение ионов Co^{3+} приводит к появлению вклада в проводимость, обусловленного возникновением делокализованных e_g -электронов, и одновременно становится возможной зарядовая диспропорционализация ионов Co^{3+} , которая приводит к снижению величины коэффициента Зеебека. В области температур, соответствующей прыжковой проводимости ($T < T^*$),



Рис. 7. Зависимость подгоночного параметра E_D от температуры. Линия соответствует функции (21).



Рис. 8. Температурная зависимость термоэлектрической эффективности $Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3-\delta}$.

основная часть ионов Co^{3+} находится в невозбужденном LS-состоянии $\mathrm{Co}^{\mathrm{III}}$ и удельная термоэдс слабо зависит от температуры.

Все исследованные образцы характеризовались низкими значениями термоэлектрической мощности ($S^2/\rho \sim 10^{-8}-10^{-6}$ W/m · K²), что обусловлено большой величиной их удельного сопротивления. На рис. 8 приведено изменение параметра S^2/ρ с температурой для соединения Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3- δ}. Зависимость $S^2/\rho(T)$ имеет максимум вблизи температуры 250 K, соответствующей величине T^* .

4. Заключение

Таким образом, в настоящей работе показано, что в эрбиевых и гольмиевых кобальтитах, легированных стронцием, при температурах T > 77 K транспорт носителей заряда осуществляется по прыжковому механизму с переменной длиной прыжка в режиме Мотта. Выполнены оценки параметров, характеризующих прыжковую проводимость в исследуемых соединениях (характеристической температуры, средних энергии и длины прыжков, плотности локализованных состояний вблизи уровня Ферми). Наблюдавшиеся корреляции между этими параметрами и средним радиусом $\langle r_A \rangle$ катионов, находящихся в А-узлах, объяснены уменьшением энергетического расщепления Δ 3*d*-орбиталей ионов кобальта, расширением зоны eg-электронов и ослаблением локализации при понижении химического давления в системе, вызванным увеличением $\langle r_A \rangle$.

В кобальтите $Ho_{0.35}Sr_{0.66}CoO_{3-\delta}$ при повышении температуры до 250 К обнаружен дополнительный вклад в проводимость, связанный с термическим возбуждением ионов кобальта. Выполнена аппроксимация температурной зависимости электросопротивления этого соединения в рамках модели, учитывающей появление канала проводимости, обусловленного возбужденными спиновыми состояниями, в матрице с полупроводниковой прыжковой проводимостью. Величина энергетической щели Δ, полученная в этой модели, составляет 200 meV.

Установлено, что величина коэффициента Зеебека исследованных соединений уменьшается при возрастании концентрации стронция и температуры. Качественно зависимость величины S от содержания стронция соответствует формуле Heikes и связана с изменением концентрации ионов Co⁴⁺.

В соединении Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO_{3-δ} в температурной области, соответствующей прыжковой проводимости, коэффициент Зеебека слабо зависел от температуры. При достижении $T^* \cong 250 \, \text{K}$ наблюдалось резкое возрастание величины |dS/dT|. Показано, что уменьшение коэффициента Зеебека в соединении Ho_{0.35}Sr_{0.65}CoO₃₋₆ при $T > T^*$ обусловлено зарядовой диспропорционализацией ионов Со³⁺. Оценка энергии расщепления 3*d*-уровней в кристаллическом поле, выполненная при расчете зависимости S(T), совпадает с величиной Δ , полученной в рамках модели двухканальной проводимости. Установлена корреляция между появлением дополнительного канала проводимости в полупроводниковой матрице с прыжковой проводимостью и началом быстрого снижения коэффициента Зеебека с температурой. Показано, что причиной изменения характера обоих кинетических процессов является термическое возбуждение ионов Со³⁺.

Список литературы

- [1] S.W. Biernacki. Phys. Rev. B 74, 184420 (2006).
- [2] V. Gnezdilov, K.-Y. Choi, Yu. Pashkevich, P. Lemmens, S. Shiryaev, G. Bychkov, S. Barilo, V. Fomin, A.V. Yeremenko. ΦHT 32, 219 (2006).
- [3] I.H. Inoeu. Semicond. Sci. Technol. 20, S 112 (2005).
- [4] J.P. Attfield. Int. J. Inorg. Mater. 3, 1147 (2001).
- [5] K. Asai, O. Yokokura, N. Nishimori, H. Chou, J.M. Tranquada, G. Shirane, S. Higuchi, Y. Okajima, K. Kohn. Phys. Rev. B 50, 3025 (1994).
- [6] J. Androulakis, P. Migiakis, J. Giapintzakis, P. Pantelis. Appl. Phys. Lett. 84, 1099 (2004).
- [7] А.А. Козловський, В.П. Хірний, Т.Г. Дейнека, О.В. Семенов. В.М. Пузіков. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 5, 609 (2007).
- [8] Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. (1989). 368 с.
- [9] Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. Электронные свойства легированных полупроводников, Наука, М. (1979). 416 с.
- [10] G. Venkataiah, V. Prasad, P. Venugopal Reddy. J. Alloys Comp. 429, 1 (2007).
- [11] Y. Liu, X.Y. Qin. J. Phys. Chem. Solids 67, 1893 (2006).
- [12] S. Pavi, Monoranjan Kar. Physica B 348, 169 (2004).
- [13] R.D. Shannon. Acta Cryst. A 32, 751 (1976).
- [14] Esa Bose, S. Karmakar, B.K. Chaudhuri, S. Pal, C. Martin, S. Hebert, A. Maignan. J. Phys.: Cond. Matter 19, 266 218 (2007).
- [15] M. Onoda, A. Sugawara. J. Phys.: Cond. Matter 20, 1 (2008).

- [16] W. Koshibae, K. Tsutsui, S. Maekawa. Phys. Rev. B 62, 6869 (2000).
- [17] I.A. Nekrasov, S.V. Streltsov, M.A. Korotin, V.I. Anisimov. Phys. Rev. B 68, 235 113 (2003).
- [18] С.Г. Овчинников, Ю.С. Орлов. ЖЭТФ 131, 485 (2007).
- [19] A. Maignan, V. Caignaert, D. Raveau, D. Khomskii, G. Sawatzky. Phys. Rev. Lett. 93, 026 401 (2004).
- [20] A. Maignan, D. Flahaut, S. Hebert. Eur. Phys. J. B 39, 145 (2004).
- [21] Jian Liu, Hong Shun Yang, Yi Sheng Chai, Li Zhu, Hao Qu, Cheng Hai Sun, Hui Xian Gao, Xu Dong Chen, Ke Qing Ruan, Lie Zhao Cao. Phys. Lett. A 356, 85 (2006).
- [22] Mei Yang, Yu Zhong, Zi-Kui Liu. Solid State Ionics **178**, 1027 (2007).
- [23] E.B. Mitberg, M.V. Patrakeev, I.A. Leonidov, V.L. Kozhevnikov, K.R. Roeppelmeier. Solid State Ionics 130, 325 (2000).
- [24] Md. Motin Seikh, B. Raveau, V. Caignaert, V. Pralong. J. Magn. Magn. Mater. 320, 2676 (2008).
- [25] H. Alloul, I.R. Mukhamedishin, G. Collin, N. Blanchard. Europhys. Lett. 82, 17 002 (2008).
- [26] J.W. Stevenson, M.M. Nasrallah, H.U. Anderson, D.M. Sparlin. J. Solid State Chem. **102**, 175 (1993).
- [27] J.J.U. Buch, T.K. Pathak, V.K. Lakhani, N.H. Vasoya, K.B. Modi. J. Phys. D 40, 5306 (2007).
- [28] M. Takano, N. Nakanishi, Y. Takeda. Mater. Res. Bull. 12, 923 (1977).
- [29] T. Pedersen, S. Saadi, K.H. Nielsen, S. Morrup, K. Kammer. Solid State Ionics 176, 1555 (2005).
- [30] H. Yokokawa, N. Sakai, T. Kawada, M. Dokiya. Solid State Ionics 52, 43 (1992).
- [31] S.R. Sehlin, H.U. Anderson, D.M. Sparlin. Phys. Rev. B 52, 11681 (1995).
- [32] R.R. Heikes, R.C. Miller, R. Mazelsky. Physica **30**, 1600 (1964).
- [33] Changjin Zhang, B.H. Kim, J.S. Kim, Y.W. Park. Phys. Lett. A 348, 58 (2005).